Random Access Memory

- 16차원 재장하는 폴로왕이나 30-64분 재장에는 HIZI스터에게 G LIPH가 더 된 크기의 데이터를 저장하는 RAM.

한 국소에 Multiple word로 제강 - 독자한 국소의 word로 길네오거나 Ӳ수 있다.

	2 × n	memory		
k ⊸	ADAS DATA	Out	-> n ADR	S: K bite3 Utrung 2Knye1 3企
			VT Ad	ナ; N PJ 434
→	CS WA		CS:	Chip Select PL, (Olon MENSS.
->	WA		WR:	Oolat usog' (old muite.

一 太子的是 图刊中 型四 外达引 五五 短别。

- DIBZ(3)1765

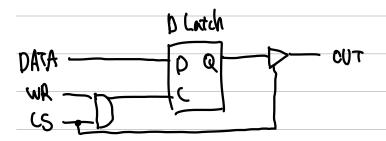
 $2^{2}bit = (Byte eles$

rKB: 210	66	
MB: 220	106	
- dβ : 730	10°9	
-TB: 240	(0 ⁽²	
Pβ : 250	10 _{(e}	

Static Memory

~ bta. coches on Lts.

latch? Algoth.



-three state buffer

IN-> 017	EN	IN	ρντ	
EN	v	χ	Pisconnected (生き刈物)	
	1	0	0	
	l	((

८५।त्राज्यव्हे इयु

DRAM

MR 现当州 野今久出, 叶叶出

371792 माम्रास्त केटाक्सा किटा

-SDRAM	Synchronaus, G1	णहार क्रे <u>न</u> िस्थलम	band mith 8 sept	
MAA ACIC	Double Down Rome	1 Tall ईया ह	<u> </u>	
ROM read-	only methory			
$\frac{2^{R} \times n}{ADRS}$	Rom	Non Volatile		
K ADRS	OUT h	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-> (S				
7,00				